—————— 科目名	半導体工学			担当教員	清水	# #			
 学年	電子制御4年	学期	通年	履修条件	必修		単位数	2	
 分野		授業形式		科目番号	08C04	30610	単位区別	履修単位	
	集積回路に関する基								
学習目標	本講義では集積回路を構成するデバイスであるダイオード,トランジスタの基本構造と動作原理								
	の理解を深めると共に、これらの製造プロセスについて基本的な部分を理解する。								
	講義を中心として行う。								
進め方	講義で学んだことを演習・レポートにより復習し習熟度を高める。								
履修要件	特になし								
学習内容	学習項	目(時間	数)			学習到	達目標		
	1.ガイダンス,量子	² 物理学と	古典物理学(2	2) 電子の波	捜動性を	理解し,	固体のエネ	ルギー準位	
	2.電子の波動性1(2)		図を理解	解する。	D2:1			
	3.電子の波動性2(2)							
	4.水素電子のエネル	レギー準位	(2)						
	5.量子数(2)								
	6.パウリの排他律,	軌道と電	子状態(2)						
	7.固体中の価電子の)振舞い(2)						
	8. 前期中間試験(2))							
	9.結晶構造,エネル	レギー帯(2)	半導体の	電気伝	導の機構	を理解する	。D2:2	
	10.導体・絶縁体・半	≐導体,バ	ンド構造(2)						
	11.真性半導体と不知	植物半導体	(2)	フェルミ	芝準位,	フェルミ	分布関数を	理解する。	
	12.不純物半導体(2)			D2:1					
	13.移動度(2)			真性半導	拿体,不	純物半導	体の物理的	性質を理解	
	14.フェルミ・ディラ	ックの分	布関数(2)	する。D	2:2				
	15.自由電子近似, #	ヤリア濃	度(2)						
	16. 前期末試験(2)]					
	17.試験問題の解答(2)							
	18.フェルミ準位(2)			pn 接合0	の物理的	な性質を	王理解し,電	気的特性を	
	19.ホール効果(2)			理解する	6. D2:2				
	20. P N接合の物理(2)		トランジ	バスタの	動作をエ	ネルギー帯	理論により	
	21.逆方向飽和電流(2)		説明でき	きる。D2	::3			
	22.降伏現象(2)								
	23.バイポーラトラン	/ジスタ(4)						
	24. 後期中間試験(2)								
	25.FET(2)								
	26.トランジスタの重	か作メカニ	ズム(2)	集積回路	め意義	, 作製方	法の概略を	理解する。	
	27.集積回路(2)			D2:1					
	28.IC の製造工程(2)								
	29.半導体の光学的性	E質(2)		半導体光	Ĺデバイ	スの基本	的な動作原	理を理解す	
	30.化合物半導体(2)			る。D2:1	1				
	31.光 - 電気変換素子	² (2)							
	32. 学年末試験(2)								
	33.試験問題の解答と			-					
評価方法	定期試験を 60% , レ	ポートと	寅習と出席率	等を 40% の比	率で総1	合評価す	る。		
明本が「	# 7 D W								
関連科目	電子回路 ,								
教材	 教科書:渡辺 秀夫 著 「半導体工学」 コロナ社								
備考	特になし								